

Метка	Название	Структурное подразделение	ЗЕТ	ч	Семестры															Практическая подготовка	Компетенции						
					1 курс					2 курс																	
					1 18 нед (ТО: 18 нед)					2 17 нед (ТО: 17 нед)					3 18 нед (ТО: 18 нед)							4 6 нед (ТО: 6 нед)					
					Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр			Лаб	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр
Б1.ДВ.2.2	Б1.ДВ.2.2.1 Компьютерные технологии: архитектура и проектирование микропроцессорных систем	27	5	180																					16	ОПК-4, ПК-11, ПК-12, УКЦ-1, УКЦ-2, ПК-10.6, ПК-10.7	
	Б1.ДВ.2.2.2 Компьютерные технологии: автоматизированное проектирование интегральных схем	3			32	16	16		40	Э(36)	30	15	15		6	Э(36)											
Б1.ДВ.2.3	Б1.ДВ.2.3.1 Физические основы нанoeлектроники	27	2	72	48	16	32		24	3															16	ПК-15, ПК-18, ПК-10.3	
	Б1.ДВ.2.3.2 Высокопроизводительные системы	3																									
Б1.ДВ.2.4	Б1.ДВ.2.4.1 Оптоэлектроника	27	2	72																					8	ПК-6, ПК-10.3, ПК-10.4	
	Б1.ДВ.2.4.2 Микросистемы	3																		32	16	16		40			3
Б1.ДВ.2.5	Б1.ДВ.2.5.1 Сенсоры и датчики в микроэлектронике	27	3	108	64	32	32		44	3/0															16	ПК-12, ПК-10.4	
	Б1.ДВ.2.5.2 Материаловедение	3																									
Б1.ДВ.2.6	Б1.ДВ.2.6.1 Цифровая обработка сигналов	27	2	72																					8	ПК-10, ПК-12, ПК-10.6, ПК-10.7	
	Б1.ДВ.2.6.2 Телевизионные и космические системы	3																		32	16	16					
Б1.ДВ.2.7	Б1.ДВ.2.7.1 Основы радиационных технологий	27	2	72																					16	ПК-19	
	Б1.ДВ.2.7.2 Методы радиационных исследований	3																		32	16	16		40			3
Б1.ДВ.2.8	Б1.ДВ.2.8.1 Элементы микро- и нанoeлектроники	27	3	108																					8	ПК-11, ПК-12, ПК-10.8	
	Б1.ДВ.2.8.2 Экстремальная электроника	3																		35	21	14	37	Э(36)			
Б1.ДВ.2.9	Б1.ДВ.2.9.1 Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле	27	7	252																					30	ПК-7, ПК-10.5, ПК-10.6, ПК-10.7	
	Б1.ДВ.2.9.2 Проектирование электронных систем	3																		48	8	24	16	60			Э(36)
Б1.ДВ.2.10	Б1.ДВ.2.10.1 Надежность и радиационная стойкость интегральных схем	27	6	216	48	16	16	16	24	Э(36), К/п	49	7	42		23	Э(36)									31	ПК-4, ПК-10.8	
	Б1.ДВ.2.10.2 Основы ядерной электроники	3																									
Б1.ДВ.2.11	Б1.ДВ.2.11.1 Элементы сбоеустойчивых систем	27	3	108																					15	ОПК-4, ПК-10.3, ПК-10.5	
	Б1.ДВ.2.11.2 Технологии нанoeлектроники	3																		45	15	30		63			3/0
Б2	Практика		45	1620																							
Б2.0Д	Базовая часть		22	792																							
Б2.0Д.1	Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая))	27	7	252																					30	ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-10.2, ПК-10.9	
Б2.0Д.2	Производственная практика (преддипломная)	27	15	540																					540	3/0	ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-10.1
Б2.ДВ	Вариативная часть		23	828																							
Б2.ДВ.1	Производственная практика (Научно-исследовательская работа)	27	20	720	16																				720	ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УКЦ-1, УКЦ-2, ПК-10.1	
Б2.ДВ.2	Производственная практика (педагогическая)	27	3	108																					30	ПК-18, ПК-19	
Б3	Государственная итоговая аттестация		6	216																							
Б3.1	Выпускная квалификационная работа	3	6	216																					216	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, УКЦ-1, УКЦ-2, ПК-10.1	
Ф	Факультативы		5	180																							
Ф.1	Военная подготовка	20	5	180																						УК-1, УК-3, УК-6	
Всего: 120+54320+180					27 ЗЕТ					33 ЗЕТ					29 ЗЕТ					31 ЗЕТ					1468 ч		
Объем аудиторных занятий (ч/нед)					17,33					15,65					19,56					16,17							
Максимальная учебная нагрузка (ч/нед)					48					52,94					52					54							
Учебная нагрузка в сессию (ч/нед)					36					45					36					36							
Зачет					3					2					3					3							
Зачет с оценкой					2					2					2					1							
Экзамен					3					5					3					1							
Курсовой проект					1															1							
Курсовая работа																											

СОГЛАСОВАНО:

И.о. нач. отдела магистратуры

Кружалова О.В.

Директор ИНТЭЛ

Стриханов М.Н.

Руководитель магистерской программы

Богаров Ю.И.